



Caratteristiche  $I_D - V_{GS}$  per transistor MOSFET ad arricchimento di tipo  $n$  (a destra) e di tipo  $p$  (a sinistra) in saturazione ( $V_{TH} = 1$  V per l'NMOS e  $-1$  V per il PMOS,  $k_n (W/L) = 0.5 \text{ mA/V}^2$ ). Per  $V_{GS} = V_{TH}$  la corrente  $I_D$  è teoricamente nulla; in pratica, in un dispositivo discreto è dell'ordine del  $\mu\text{A}$ , mentre quella per  $V_{GS} = 0$ , detta  $I_{DSS}$  è dell'ordine del  $n\text{A}$ .